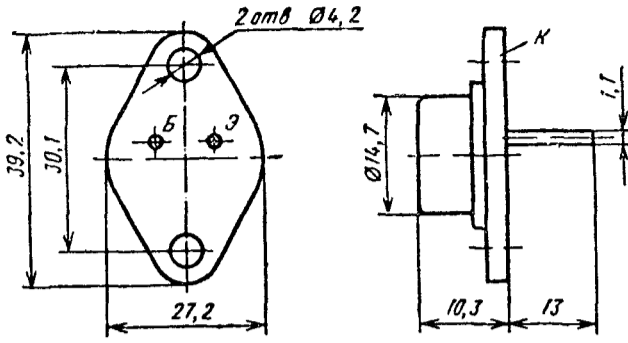


КТ865А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* импульсный. Предназначен для применения в источниках вторичного электропитания, преобразователях, оконечных каскадах усилителей звуковой частоты, стабилизаторах напряжения. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=4$ В, $I_B=2$ мА:	
$T=+25^\circ\text{C}$	40...200
$T=+125^\circ\text{C}$	40 250
$T=-60^\circ\text{C}$	15..200
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=10$ В, $I_K=0,2$ А, не менее	15 МГц
типичное значение	20* МГц
Граничное напряжение при $I_K=0,05$ А, не менее	160 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=6$ А, $I_B=0,6$ А, не более	2 В
типичное значение	0,7* В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=6$ А, $I_B=0,6$ А, не более	2 В
типичное значение	1* В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ}=200$ В:	
$T=+25^\circ\text{C}$	0,1 мА
$T=+125^\circ\text{C}$	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=6$ В, не более	3 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ}=5$ В, не более	300* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ}=0,5$ В, не более	2000* пФ

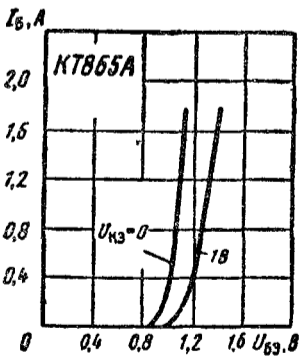
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база при $dU_{КБ}/dt \leq 200$ В/мкс	200 В
Постоянное напряжение коллектор — база при $R_{бэ} \leq 10$ Ом, $dU_{КБ}/dt \leq 200$ В/мкс	200 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	6 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 1$ мс, $Q \geq 2$	15 А
Постоянный ток базы	2 А
Импульсный ток базы при $t_u \leq 1$ мс, $Q \geq 2$	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60 \dots +25^\circ\text{C}$	
с теплоотводом ¹	100 Вт
без теплоотвода ²	1,5 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	-60 °C $T_K = +125^\circ\text{C}$

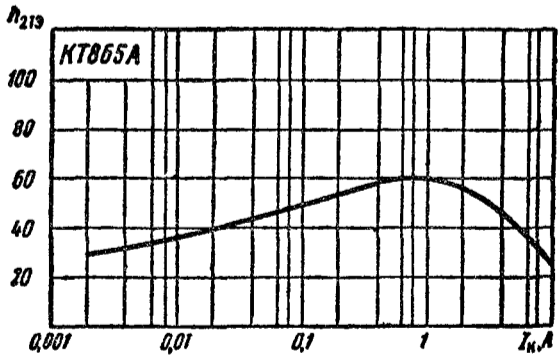
¹ При $T_K = +25 \dots 125^\circ\text{C}$ $P_{К, макс}$ снижается линейно до 20 Вт.

² При $T = +25 \dots +125^\circ\text{C}$ $P_{К, макс}$ снижается линейно до 0,3 Вт.

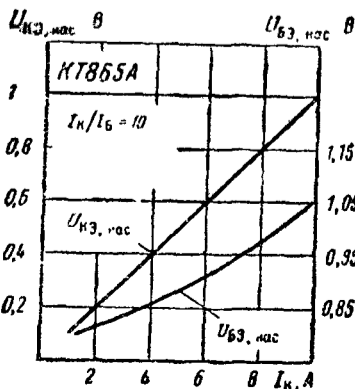
Пайка выводов транзистора рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса при температуре +270 °C в течение не более 3 с, время лужения не более 2 с. Допускается не более трех перепаяк выводов.



Входные характеристики



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора при $U_{КБ}=4$ В



Зависимости напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от тока коллектора